PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-124017

(43)Date of publication of application: 27.05.1991

(51)Int.Cl.

H01L 21/027 G03F 7/30

(21)Application number: 01-261501

(71)Applicant: TOKYO ELECTRON LTD

(22)Date of filing:

06.10.1989

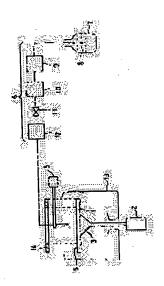
(72)Inventor: USHIJIMA MITSURU

(54) TREATMENT AND DEVICE THEREFOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent development of treatment irregularities and to enable high precision treatment by supplying treatment solution to a treatment object and allowing it to stay thereon, and by relatively heating and cooling a central part and a peripheral part of the treatment object to realize a uniform treatment temperature.

CONSTITUTION: A wafer 1 which is a treatment object is mounted and fixed on a treatment device. A nozzle is provided above a central part of a circular part of a chuck 3 which is fixed to a rotating axis of a motor 2 and whose upper side is a circular supporting base. The nozzle is connected to a developing solution supply system 6 and a scanner 5 allows the nozzle to move freely, which is provided to retire it from above the chuck 3 to the outside position. A cup 13 is provided, surrounding the chuck 3 as a treatment container. A ultraviolet ray lamp 14 which is a heating means to keep a treatment temperature uniform is provided in a loop



above a peripheral part S of a wafer 1 so that it can heat to compensate to a central part of the peripheral part S of the wafer 1. The ultraviolet ray lamp 14 heats the peripheral part S weakly during development to prevent occurance of development irregularities during development.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-124017

@Int.Cl.5

識別記号

庁内勢理番号

@公開 平成3年(1991)5月27日

H 01 L 21/027 G 03 F 7/30

502

7124-2H

2104-5F H 01 L 21/30

361 L

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

69発明の名称

処理方法及び処理装置

②特 顧 平1-261501

②出 顋 平1(1989)10月6日

⑩発明者 牛島

进

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株

式会社内

而出 願 人 東京:

東京エレクトロン株式

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

会社

四代 理 人 弁理士 守谷 一雄

明相の書

1. 発明の名称

処理方法及び処理装置

2. 特許請求の範囲

1. 被処理体上に処理被を供給溶在させて処理 する際に、前記被処理体の中心部及び周辺部で処 理温度が均一になるように相対的に加温又は冷却 することを特徴とする処理方法。

2. 被処理体上に処理液を供給滞在させて処理 する装置において、前記被処理体の中心部及び周 辺部で処理温度が均一になるように相対的に加温 又は冷却する手段を具備したことを特徴とする処 理装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、処理方法及び処理装置に関する。

[従来の技術]

従来から、半導体ウェハの製造工程で、ウェハ を現像処理する工程がある。即ち、CVD、スパ ッタ装置等でウェハ上に成膜されたSiO,膜や ポリシリコン等の薄膜上全面に均一にレジストを 塗布し、マスクと呼ばれるパターンを通して光を あてレジストに光反応を生じさせた後、現像工程 を行うためにデベロッパが用いられている。現像 液としては、露光部分が光分解反応し現像液に可 溶となったレジストを除去してウェハ上にパター ンを形成するポジ型と、 露光部分が架構反応を生 じて現像液に不溶となったことを利用して未露光 部分のレジストを除去してパターン形成するネガ 型がある。また、現像被の供給方法はディップ型 や現像液供給系のパイプの先端のノズルより噴霧 状の液をウェハ表面に吐出させるスプレー型、現 像液の表面表力を利用してウェハ上に現像液を盛 り上げるパドル型等がある。現在の超LSIでは レジストパターンも微細化が要求され、レジスト として、解像度の優れたしかもリソグラフィに統 くエッチングに際して強い耐性を持ち、さらに強 布される面との密着性のよいノポラック樹脂ーナ フトキノンジアジト系等のポジ型レジストが主に 用いられている。それらのレジストは光照射によ

り分解されアルカリ水溶液可溶となるため、現像 液にはアルカリ水溶液が使用されている。現像装 置としては現像ムラや装置面からパドル型が主流 となっている。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は上記の欠点を解消するためになされた ものであって、処理中の処理液温度差による処理

第1図に図示の処理装置であるパドル型デベロ ッパは真空吸着等によって被処理体であるウェハ 1を載置固定し、モータ2の回転軸に固定される 上面が円形状の支持台であるチャック3の円形中 心部上方にノズル4が設けられる。ノズル4はロ ットの切れ目等で必要ならばダミーディスペンス を実行することができる。即ち、ノズル4をチャ ック3上方から外側位置に退避させるためのスキ ャナー5により移動自在となっている。このノズ ル4が接続される現像被供給系6は現像被収納容 器7に収納された処理液である現像液8を均一に 供給するポンプ9例えばベローズポンプ等、フィ ルタ容器10及びポンプ9に運動して開閉される バルブ11、現像被8をノズル4内に引き戻し、 現像被の液だれあるいは固化を防止するためサッ クバックバルブ12等から構成される。現像供給 系6には図示しない温度調節機構が設けられ、現 像被及びレジストの種類等により適温に調整する ように構成される。また、現像被供給時及び現像 液洗浄時に装置外部へ現像液や洗浄液が飛散する

ムラを除去した処理装置を提供することを本発明 の目的とする。

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するため本発明の処理方法は、 被処理体上に処理液を供給滞在させて処理する際 に、前記被処理体の中心部及び周辺部で処理温度 が均一になるように相対的に加温又は冷却する。

また、上記の処理方法を実現する処理装置は、 被処理体上に処理液を供給溶在させて処理する装 置において、前記被処理体の中心部及び周辺部で 処理温度が均一になるように相対的に加温又は冷 却する手段を具備したものである。

[作用]

被処理体の周辺部に生じる温度低下を相殺する 手段を設けたので、被処理体全面を均一な温度に 保持することができ、処理ムラを生じることなく、 均一な処理を行うことができる。

[実施例]

本発明をパドル型デベロッパに適用した一実施 例を図面を参照して説明する。

のを防止するため処理容器としてカップ13がチャック3を包囲して設けられる。カップ13は上下動可能であってウェハ1の図示しない搬送機構による搬入出時には図示の位置より下降し、チャック3が露出してウェハの搬入出を容易にする。カップ13の下部には俳気管等(図示せず)が接続される。さらに本発明の特徴である逸赤外線ランプ14がウェハ1の周辺部Sを中心部に対し補償するよう加熱可能にウェハ1の周辺部Sの上方に円環状に設けられる。

次に現像方法について説明する。

ウェハ1が図示しない搬送機構によりチャック 3上に載置されると、ウェハ1はチャック3に吸 着支持されカップ13は第1図に図示のように上 昇し、ウェハ1上に現像被供給系6より一定量の 現像被8がノズル4より例えば2~5秒間内で流 下され、現像被8の表面張力によりウェハ1に塗 布されパターン露光済のレジスト膜R上に第2図 に示すように滞在させる。この時必要ならば極め て低速(例えば10rpm)でモータ2を回転さ せ、ウェハ1上に現像被8が迅速に行き渡り、か つ表面張力により飛散してしまわないようにウェ ハ1を回転させてもよい。ウェハ1上に現偽粧8 を30~120秒間通常60秒間滞在させ現像を 進行させる。現像時間はレジスト膜の種類、膜厚 及び現像液の種類、温度により適宜選択する。例 えば現像液としてコリンを用いる場合、コリンは 50°~60°で現像を行うと非常に短時間で現 像できるが均一な現像が行えず制御が困難である。 しかし例えば30℃で上記の時間の現像を行うと 均一な現像を行うことができる。この現像時間中、 遠赤外線ランプ14を極めて弱い光線を発生する よう作動させ、ウェハ1の周辺部Sを中心部に対 して補償するよう加熱する。このように周辺部S を微弱に加熱することにより第3図に示すように ウェハ1の現像時間と中にウェハ1の中心部の温 度低下勾配Cと周辺部の加熱を行わない状態の時 に生じるウェハ1の周辺部5の温度低下勾配51 との差を相殺し、周辺部Sにおいてもウェハ1の

置、洗浄装置、コーター等のようにウェハ表面に 強布された被体が所望温度に、また均一温度で処 理する装置に適用可能である。

[発明の効果]

以上の説明から明らかなように、本発明の処理 方法及び処理装置によれば、被処理体を所望温度 に中心部と周辺部に生じる温度不均一を相殺する 手段を設けたため、被処理体全面を均一な温度に 保持することができ、処理ムラを生じることがな い。従って、高精度な処理が可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の構成図、第2図及 び第3回は第1図に示す一実施例を説明する図、 第4回は他の実施例の要部を示す図である。

1・・・・・被処理体(ウェハ)

3・・・・・チャック (支持台)

6 · · · · · · 現像被供給系

8 · · · · · 处理液 (現像液)

14・・・・遠赤外線ランプ

中心部と同様の温度低下勾配Cを保持することが できる。このため、ウェハ1の全域に耳り、温度 を均一にすることにより現像ムラを生じることが ない。

以上の説明は本発明の一実施例であって、本発明はこれに限定されるものではない。即ち、遠赤外線ランプによるウェハ周辺部9の加熱にならばよりェハ全面の温度を均一に保持するも数ではなったのは、第4回に対するような大型であるいいは、カーションでを関するか、あるいいのは、周辺部をからしてもよい。また、ウェハのは、カーを企って、カーを発生を対して、カーで、カーを発生を対して、対象によった。とができ好きである。

上記実施例では、現像処理装置に限定して説明 したが、これに限るものでなく、レジスト塗布装

(加温又は冷却する手段)

15・・・・ヒータ (加温又は冷却する手段)

S······周辺部

R・・・・・レジスト膜

代理人 弁理士 守 谷 一 雄

特閒平3-124017 (4)

